U.D.C. 621.313.23:621.316.7

最近の HTD とその 応用

西 政 隆*

The Modern HTD and Its Applications

By Masataka Nishi Hitachi Works, Hitachi, Ltd.

Abstract

The development of automatic control engineering which was urged by wartime needs has been still continuing its large stride not only in the sphere of theoretical research but in industrial applications alike. And this necessarily means the progress of the amplifier. The amplifier is now demanded to have hundred to several thousand watt capacity as its application has been extended to the control of such machines, whose capacity reaching sometimes several thousand kilowatt. For this reason it has become a favoured practice for the control of electromagnetic power to employ the rotating amplifier and, if the application is of static nature, to use magnetic amplifier.

Hitachi's HTD or the rotating amplifier, is the product originally developed

from HLG, its capability has been testified by a large number of users in its 20 years' history in various industries including iron, paper, mining, construction and other industries.

The essential requirements on the rotating amplifier are the high amplifying factor and the small time constants, and both of them are successfully incorporated in the HTD of the newest design.

〔I〕緒 言⁽¹⁾⁽²⁾

製鉄,製紙,鉱山などを始めとする一般電動力応用方 面における技術の進歩は,最近目覚しいものがある。特 に戦時中発達した自動制御工学の最近における著しい理 論的進展に伴い,その実施活用による電動力応用方面の 進歩発達は特に顕著である。

電動力応用方面における自動制御の目的は最終的には 電動機の速度出力などを所定の計画通り,または運転者 の指令通り正確迅速に制御することであり,正確のため には高い精度が,迅速のためには大なる速応性が不可欠 の要件である。

自動制御方式としては一般に電動機速度または電流な どの被制御量を指令点に負饋還して,閉ループを形成す るのであるが(第1図参照),その精度を上げるためには 閉ループ全体の増幅率を上げる必要があり,大きな増幅

* 日立製作所日立工場



- 第1図 被制御量を指令点に負饋還する負 饋還制御方式
- Fig.1. Negative Feed Back Control in which the Controlled Value is Negatively Fed Back to the Commanding Point

率をもつ増幅器が必要となる。しかるに電動力応用部門 では、数百ないし数千キロワットにおよぶ大容量を制御 する場合が多く、増幅器出力も数百ワットから数キロワ ットに達する大容量のものとなるので、増幅器としては、 回転電機型のものか、静止型のものでは磁気増幅器が用 いられるのが普通である。

回転型増幅機は十数年前に始めて発表されたもので,

日立評論 電動力応用特集号 別冊第8号



第2図 標 準 型 HTD 1kW 110V 1,500/1,800 rpm Fig. 2. HTD of Standard Model 1kW 110V 1,500/1,800 rpm

戦後自動制御工学の発達とともに,種々の改良と新しい 型の発展が行われた。現在用いられているものには,正 饋還を行うもの,横軸刷子を有するものおよびこの両者 の組合わされたもの等がある。

日立製作所が採用している回転型増幅機 HTD は,日 立製作所独特の HLG⁽³⁾より発達したもので,20 年近





い歴史を有する正饋還型増幅機である。

回転型増幅機,磁気増幅器などはいずれも出力電圧発 生に磁束を用いるものであるから,この磁束とそれを発 生する線輪とによつて定まる時定数の影響で,出力変化 に時間的遅れを生じ過渡特性が害される傾向となるのは 避けられない。増幅器の過渡特性が悪い場合には,被制 御量の過渡特性もまた悪くなるからできるだけ時定数を 短縮することが必要である。しかるに増幅率をあげると 一般に時定数は伸びる傾向にあるから,いかにして時定 数の短いしかも増幅率の大きい増幅器を実現するかご最 も重要な問題である。

日立製作所は最近従来の HTD に本質的改善を行い, その時定数を飛躍的に短縮し,過渡特性を著しく改善し た新型分極 HTD を完成した。その特長は増幅作用を行 う正饋還が制御入力界磁と磁気的に独立した磁路をもつ ことであり,その効果性能については後節に詳述する。

〔II〕回転増幅機 HTD の概要

(1) 増幅原理とその特長

HTD は正饋還型の増幅発電機であり,その出力は入 力と出力からの自己正饋還量の和によつて与えられる。 この正饋還は自励分巻界磁によつて行われるものでその 他の点では普通の直流発電機と原理的になんら変るとこ ろはない。第3図にHTDの接続図を,第4図にその増 幅原理を示す。入力電圧がどのようにして出力側に伝達

- A: 分巻界磁の抵抗線
- B: 入力量が与えられた場合の分巻界磁の抵抗線で直線Aに平 行である。
- C: 飽和曲線
- 第4図 HTD の 増 幅 作 用

Fig.4. Amplifying Performance of HTD



されているかを示すために,普通ブロックダイヤグラム によるのが便利であり,第5図および第6図に HTDの 無負荷のときのブロックダイヤグラムを示す。



- 視した場合の HTD ブロックダイヤグラム
- Fig. 6. Simplified Block Diagram of HTD, when Neglecting the Armature Internal Resistance and Inductance

入力電圧が与えられると、その制御入力界磁の抵抗と 巻数およびその磁気回路の磁気抵抗で定る磁束となり、 これが電機子導体およびその回転数によつて定る電圧を 発生する。電圧を発生すると分巻界磁に電流が流れ、こ れがその巻数とその磁気回路の磁気抵抗で定る磁束とな つてさらに出力電圧を増す。この関係は HTD の飽和曲 線が直線である範囲内で、分巻界磁による正饋還度を等 比とする無限等比級数的な累加となつて、僅かな入力に 対し大きな出力電圧を発生し、大電力を供給し得ること になる。第6図のブロックダイヤグラムより、HTD の 伝達函数として



第7図 単位函数とその周波数分布 Fig.7. Unit Function and its Frequency Spectrum

この場合電機子の利用度としては, 普通の他励磁発電 機では入力磁束から出力電圧に至る間にたゞ1回利用し ているにすぎないが, HTD ではこの正饋還によつて無 限大回数に利用されると考えることもできる。

つぎに過渡特性について考える。それには便宜上単位 函数の入力電圧を加えた場合の出力電圧の応答すなわち インディシアル・レスポンスを求めてもよいが,いろい ろな周波数の正弦波函数の電圧を加えた場合の出力を求 めることによつても知ることができる。このことは,真

を得るが、この式で

$$\left(\frac{V}{A_T}\right) \cdot \left(\frac{N_s}{\gamma_s}\right)$$

が正饋還度を表わす公比であり,

$$\left(\frac{V}{A_T}\right) \cdot \left(\frac{N_c}{\gamma_c}\right)$$

は分巻界磁のない単なる他励磁発電機としての増幅率を 示す。われわれは

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{V}{A_T}\right) \cdot \left(\frac{N_s}{\gamma_s}\right)}$$

を同調率と名付,これを μ であらわす。

空管増幅器でその周波数特性を問題にするのと同じよう な考え方である。

一方単位函数についてみても、そのうちには零から無限大までの周波数の正弦波が、連続的に含まれているもので、周波数 ω の成分の振幅は $\frac{\delta\omega}{\pi\omega}$ で与えられる。その周波数と振幅の関係は第7図に示す通りである。したがつて単位函数の電圧を加えた場合の出力の応答は、単位函数を構成する各成分周波数の正弦波函数に対する出力の和となり、その増幅機の周波数特性と密接な関係があるわけである。そこでまず HTD の周波数特性について考える。

(2) HTD の周波数特性

最初に増幅率に関する周波数特性を考えよう。いま零から無限大までの周波数の正弦波電圧を入力として加えた場合を考えると、これによる発生磁束は界磁線輪のインダクタンスのために周波数が大きくなるにつれて減少し、さらに分巻界磁による正饋還量もまた周波数がますにつれて減少する。したがつて周波数が高くなるにつれてHTDの増幅率は次第に低下する性質がある。この特性は磁束を用いて電圧を発生する発電機にはすべて共通のものである。HTDの電圧増幅率は(1)式より

$$A_{V} = 20 \log_{10} \mu \cdot \left(\frac{V}{A_{T}}\right) \cdot \left(\frac{N_{c}}{\gamma_{c}}\right)$$

-10 log₁₀[1+{ $\mu(\tau_c + \tau_s)\omega$ }²] (db)....(2) で与えられることになる。



また実際の場合には、HTD の入力側の前段および出 力側の後段で問題となるものは常に電力であり, 増幅器 単独として考える場合には電力増幅率を問題にしなけれ ばならない。いま負荷を RL という純抵抗とした場合, HTD の電力増幅率の周波数特性は次式で与えられる。

 $A_{p} = 20 \log_{10} \mu \cdot \left(\frac{V}{A_{T}}\right) \cdot \left(\frac{N_{c}}{\gamma_{c}}\right) + 10 \log_{10}\left(\frac{\gamma_{c}}{R_{L}}\right)$

 $-5\log_{10}[1 + \{\mu(\tau_{c} + \tau_{s})\omega\}^{2}] (db)....(3)$

横軸に周波数の自然対数をとつて, これらを図示すれ ば第8図の A_p, A_vのようになる。 すなわち周波数特 性は

$$\omega_1 = \frac{1}{\mu(\tau_1 + \tau_2)} \quad (rad/s)$$





の点までほぼ水平で, それから周波数が高くなるにつれ て電圧増幅率は 20 db/decade, 電力増幅率は 10 db/ decade の割合で減衰する。普通の設計では、分巻界磁 の時定数は入力制御界磁のそれに比べて十分に小さくな つているので,この水平な周波数領域を与える限界の周 波数 ω_1 はほぼ $\frac{1}{\mu \cdot \tau_0}$ となる。

周波数に対する他の1つの重要な特性に, 位相特性が ある。この位相特性をおくれ角θで表わすと,(1)式より

 $\theta = \tan^{-1} \mu(\tau_c + \tau_s) \cdot \omega \quad (\text{degree}) \dots (4)$ となる。すなわち、周波数がますと位相おくれは大きく なり, 増幅率の周波数特性が水平な限界点で45°となり, ついに90°に達する。その関係を前述と同一ので。、て。の 値につき図示すれば第8図の通りである。

なお第9図に 1kW, 110 V, 1,500 rpm, FCO-SP (開放,自己冷却型,両側ボールベアリング付)HTDの 増幅率,位相おくれの周波数特性の実測の一例を示す。

(3) HTD のインディシアル・レスポンス特性

インディシアル・レスポンスは単位函数を構成する連 続分布の周波数に対する上記の増幅率、位相おくれ特性 を綜合したものとして表わされる。また(1)式からも, その出力電圧の応答としてつぎの式を得る。

$$V_{0} = \mu \cdot \left(\frac{V}{A_{T}}\right) \cdot \left(\frac{N_{c}}{\gamma_{c}}\right) \frac{1}{1 + \mu(\tau_{c} + \tau_{s})p} \mathbf{1}$$
$$= \mu \cdot \left(\frac{V}{A_{T}}\right) \cdot \left(\frac{N_{c}}{\gamma_{c}}\right) \cdot (1 - \varepsilon^{-\frac{T}{\mu(\tau_{c} + \tau_{s})}}) \dots (5)$$

第10図 HTD のインディシアル・レスポンス

Fig. 10. Indicial Response of HTD



第11図 HTD のインディシアル・レスポンス実測例 Fig.11. One of the Test Data of HTD Indicial Response

すなわちその応答は µ(τ c+τ s) ≒µτ c を時定数とす る指数函数的な立ち上りとなる。これを図示すれば第10 図の通りである。最初の瞬間における電圧上昇率は

$$\frac{\mu \cdot \left(\frac{V}{A_T}\right) \cdot \left(\frac{N_c}{\gamma_c}\right)}{\mu \cdot (\tau_c + \tau_s)} \doteq \left(\frac{V}{A_t}\right) \cdot \left(\frac{N_c}{\gamma_c}\right) \cdot \frac{1}{\tau_c} \dots (6)$$

で与えられる。なお第11図に 1kW, 110V, 1,500 rpm の HTD のインディシアル・レスポンスの一例を示す。

新型分極 HTD の特長とその特性⁽⁴⁾ $[\mathbf{III}]$

前にのべたように, HTD はその飽和曲線を直線状の ものとし、自励分巻界磁の抵抗線をこれとほぼ一致させ る同調作用によつて1に近い正饋還を行い,これによつ て増幅率を著しく増大させているのであるが、この正饋 還は出力電圧から磁束の形に変換されるので、自励分巻

HTD 用 最 近 その応 D と



Fig.12. Block Diagram of Divided Pole Type HTD



- 第13図 標準型分割磁極型 HTD の外観 1 kW 110 V 1,500/1,800 rpm
- Fig. 13. External View of Divided Pole Type HTD of Standard Model 1 kW 110 V 1,500/1,800 rpm



第14図 1kW HTD セット Fig.14. 1kW HTD Set

界磁が入力制御界磁およびその他の用途の界磁と同一磁 極に巻いてある場合には,それらすべての界磁の時定数 の影響でこの正饋還量は高周波になるにつれて減少し, ついにある程度以上の周波数に対しては,その効果が失 われてゆく傾向となる。この場合, 饋還量の時定数が, その饋還を行う分巻界磁以外の他のすべての界磁の時定 数の和となるため,比較的低周波数で正饋還効果が減少 するきらいがあつた。

また第8図の周波数特性あきらかなように、水平な周 波数特性の領域を拡張するためには、同調率 # および入 力制御界磁の時定数で。を小さくしなければならない。 ところがて。を小さくすると増福率も比例的に低下する 傾向となり、また同調率に関してはμを大きくとれば増 幅率は比例的に増大するが,水平な周波数特性の領域は 反比例的に減少する。結局, HTD における同調, すな わち正饋還は $\omega = \frac{1}{\mu \tau_c}$ 以下の低周波に対しては 増幅 率 をμ倍する如く100%有効であるが、ωの増大とともに その効果を減じ $\omega > \frac{1}{\tau}$ で全く無効となるのである。

なお HTD には、入力制御界磁のほかに各種用途の界 磁が巻かれている場合が多く,この場合で。は,それらの 界磁の時定数の総和となるので,その値は増幅率に対応



第15図 標準型分割磁極型 HTD の固定子 1 kW 110V 1,500/1,800 rpm Fig. 15. Stater of Divided Pole Type HTD of Standard Model 1 kW 110V 1,500/1,800 rpm

する値すなわち入力制御界磁単独の時定数以上に大きく なり、HTD の周波数特性を悪くする原因となつている。 したがつて, 饋還量を分巻界磁以外の界磁の時定数に 無関係とするとともに, 分巻界磁の時定数も小さくする ことができれば高周波部分における増幅率を改善し得る

特 号 別冊第8号 用 集 電 動 力 応 日立評論



第16図 分 極 HTD の 周 波 数 特 华 Fig. 16. Frequency Characteristics of Divided Pole Type HTD

わけである。この要求に応えたものが新型分極 HTD で あり,分巻界磁は入力制御界磁などと別の磁極に巻かれ, 磁気的に完全に絶縁された設計となつている。この場合 の伝達機構をブロックダイヤグラムで示せば第12図のよ うになる。

(1) 分極 HTD の 周波数特性

第12図のブロックダイヤグラムより分極 HTD の伝達 函数としてつぎの式を得る。







したがつてその電圧増幅率は

 $A_{V} = 20 \log_{10} \mu \cdot \left(\frac{V}{A_{\pi}}\right)_{c} \cdot \left(\frac{N_{c}}{\tau_{c}}\right)$ +10 $\log_{10} \{1 + (\tau_s \omega)^2\} - 10 \log_{10} \{1 + (\tau_c \omega)^2\}$ $-10 \log_{10} \{1 + (\mu \tau_s \omega)^2\}$ (db)(8) となり、電力増幅率は負荷として RL という純抵抗をつ ないだ場合には

 $A_{p} = 20 \log_{10} \mu \cdot \left(\frac{V}{A_{\pi}}\right)_{c} \cdot \frac{N_{c}}{r_{c}} + 10 \log_{10} \frac{V_{c}}{R_{L}}$ $+10 \log_{10} \{1 + (\tau_s \omega)^2\} - 10 \log_{10} \{1 + (\mu \tau_s \omega)^2\}$ $-5 \log_{10} \{1 + (\tau_c \omega)^2\}$ (db)....(9)

となる。横軸に対数目盛で周波数をとつた場合の電圧, 電力増幅率は第16図の通りである。

。水平な周波数特性の限界点は $\omega_1 = \frac{1}{\tau}$ または $\omega_2 = \frac{1}{\mu\tau}$ の中の小さい方である。普通の設計としては、て。をて。 よりも遙かに小さくしているから, 実際問題としてとり 得るようなルの最大の値に対しても、て。とルて。とをほぼ

第18図 分極 HTD 周波数特性の実測例 Fig. 18. One of the Test Data of Divided Pole Type HTD Frequency Characteristics



第19図 分極 HTD のインディシアル・レス ポンス実測例

Fig.19. One of the Test Data of Divided Pole Type HTD Indicial Response

同一オーダーとすることができる。したがつて, 旧型の HTD に比べて水平な周波数特性の領域は、同一の増幅 率に対してほぼ#倍だけ拡張されたことになる。

 $\omega = \frac{1}{\tau}$ または $\frac{1}{\mu\tau}$ の中の小さい方から高周波分に 対しては電圧増幅率は 20 db/decade で減衰し, 電力増 幅率は $\frac{1}{\tau} > \frac{1}{\mu\tau}$ の場合には 10 db/decade, $\frac{1}{\tau} < \frac{1}{\mu\tau}$

の場合は 20 db/decade で減衰する。 さらに $\omega_1 = \frac{1}{\tau_c}$ と $\omega_2 = \frac{1}{\mu \tau_s}$ の中の大きい方から高周波分に対しては電 圧増幅率は 40 db/decade, 電力増幅率は 30 db/decade で減衰し、つぎに $\omega_3 = \frac{1}{\tau}$ より高い周波数に対しては、 (7)式の通過函数よりもあきらかなように (1+rsp)とい う進相要素によつて、電圧、電力増幅率はいずれも20 db/decade で増大させられるから,結局この部分では電 圧増幅率は 20 db/decade, 電力増幅率は 10 db/decade で減衰することになる。

したがつて、分極 HTD では旧型の HTD に比べて、 $\frac{1}{\mu\tau_{c}} \leq \omega \leq \frac{1}{\tau_{s}}$ の周波数領域で、その増幅作用が大いに 改善されることになり、 て。を十分小さくとれば,相当な 高周波領域まで周波数特性は改善される。

つぎに位相おくれ0は, (7)式よりあきらかなように,

 $\theta = \tan^{-1} \omega \tau_c + \tan^{-1} \omega \mu \tau_s - \tan^{-1} \omega \tau_s$ (degree)(10)

で与えられる。周波数が高くなるにつれて, 位相おくれ は増すが、(1+で。p)という進相分によつてある程度以上 の周波数になると逆に減少し始め, 無限大の周波数に対 して90°の位相おくれとなる。

[IV] HTD の性能値 (Figure of Merit)

増幅機の過渡特性をあらわすものとして,周波数特性 とインディシアル・レスポンスについては以上詳記した 通りであるが、これをもつと簡単にたとえば1つの数字 であらわすことができれば非常に便利である。このため 性能値 (Figure of Merit) として電力増幅率と時定数 の比であらわすことがある。しかしこのあらわし方は, 従来の HTD のように時定数がたゞ1 箇の場合は問題な いが, 分極 HTD のように多くの時定数をもつもの, ま たは横軸刷子を有する増幅機などに対しては, 等価時定 数のきめ方に問題があり,またたとえそれがきめられた としても, 通過函数の函数形が異る場合には, 同一の性 能値に対しても全体としては相当異つた周波数特性をも つ場合がありうるので, 増幅作用の異り, 通過函数の異る 増幅機の過渡特性の比較を行う場合には不適当である。

従来の HTD の性能値は,静的増幅率が十分大きい場 合には、 増幅率が 0 db となるカットオフ周波数 (Cut off Frequency)を示すことになる。そこで以下に従来 の HTD と分極 HTD のカットオフ 周波数について考え てみることにする。

(2) 分極 HTD のインディシアル・レスポンス この場合のインディシアル・レスポンスは,

で与えられ, また $\tau_c = \mu \tau_s$ とすれば

$$\left\{1 - \varepsilon^{-\frac{t}{\tau_c}} \left(1 + \frac{t}{\tau_c}\right)\right\} \cdot \mu \cdot \left(\frac{V}{A_T}\right)_c \cdot \left(\frac{N_c}{\tau_c}\right) \dots (12)$$

となる。

これを図示すれば第17図の通りである。最初の瞬間の 出力電圧の立上りの傾斜は進相要素の効果によつて,同 調率および分巻界磁の時定数に無関係になり

で与えられ,そのおのおのの数値が等しいときには旧型 HTD と同一となる。しかし時間がたつにつれて $\frac{1}{\mu\tau_{c}} \leq \omega \leq \frac{1}{\tau_{c}}$ の部分の周波数特性の良好なことのため に、速応性のよくなつていることは第10図と比較してみ ればあきらかであろう。

なお第18図および第19図に 1kW, 110 V, 1,500 rpm FCO-Sp 分極 HTD の周波数特性,およびインディシ アル・レスポンスの実測例を示す。

HTD では静的電力増幅率 Apo は

$$A_{p0} = \frac{\mu \cdot p \cdot \phi \cdot v_a \cdot (A_c) \cdot N_c}{\gamma_c \cdot i_c} \times 10^{-8} \dots \dots \dots (14)$$

また時定数は

となる。

$$\mu(\tau_{c} + \tau_{s}) \coloneqq \mu\tau_{c} = \frac{\mu \cdot p \cdot \phi \cdot N_{c}^{2}}{\gamma_{c}} \times 10^{-8} \quad (s) \dots (15)$$

こゝで p: 極 数

- $\phi: 1A_T$ でできる毎極磁束数 (Maxwell)
- va: 電機子周辺速度 (cm/s)
- (A_c) : i_c に対応する電機子アンペア

したがつてカットオフ周波数は

$$\omega_{0} = \frac{A_{p0}}{\mu(\tau_{c} + \tau_{s})} \stackrel{=}{\Rightarrow} \frac{K_{1} \cdot \mu \cdot v_{a}(A_{c})}{B \cdot \delta} = 4f \cdot \frac{(A_{Ta})}{(A_{Tc})}$$
$$= 4 \cdot \mu \cdot f \cdot \left(\frac{A_{Ta}}{A_{Tf}}\right) (rad/s) \dots (16)$$

- こムで B: アンペアコンダクター (A.) を与える主 極空隙部分の磁束密度 (gauß)
 - δ: 主極空隙長 (cm)
 - f: 電機子内電流のもつ周波数 (cycle/s)
 - (A_{Ta}) : 毎極入力制御界磁アンペアターン (A_{Tc}) に対応する毎極電機子アンペアター ン (A)
 - (A_{Tf}) : 入力制御界磁 (A_{Te}) に正饋還の加わつた 全界磁アンペアターン (A) K1: 定数

すなわちカットオフ周波数は同調率,電機子周速,ア ンペアコンダクターなどの積に比例し,空隙磁束密度と 空隙長の積に反比例する。あるいは同調率と周波数に比 例し,電機子アンペアターンと全界磁アンペアターンの 比に比例するという簡単な関係となる。したがつてカッ トオフ周波数を大きくするためには v_a と A_c を大に B,δ などを小とすることすなわちf および A_{Ta} と A_{Tf} の比を大とすることが必要であるが,整流および電機子 反作用の点から制限されるので,カットオフ周波数の値 には設計上おのずから限度がありある程度以上大きくす ることは困難である。

分極型 HTD では

$$A_{p0} = \frac{\mu \cdot p \cdot \phi \cdot v_a \cdot (A_c) \cdot N_c}{\gamma_c \cdot i_c} \times 10^{-8} \dots \dots \dots \dots (17)$$

こゝで ϕ : 入力制御磁極に $1A_T$ を与えたとき同磁 極に発生する磁束 (Maxwell)

入力制御界磁の時定数は

また分巻界磁の時定数は μ が十分に大きいとすれば,

御界磁のほかに多くの界磁があり、て。が入力制御界磁の 時定数より大きくなる普通一般の場合に対しては、分極 HTD の長所が遺憾なく発揮されきわめて有利となる。

〔V〕実際への応用例

HTD は,被制御量の検出方法さえ考慮すれば,いかな る物理量もこれを制御することができるが以下電動力応 用方面における代表的な二,三の実用例についてのべる。

(1) セクショナルドライブ方式抄紙機の速度制御 抄紙機の容量,速度などの最近における著しい増大に 伴い,その駆動方式も主としてセクショナルドライブ方 式が採用されるようになつた。この場合抄紙速度の絶対 値および各セクション間の相対速度を厳密に一定に維持 することが必要であり,HTD が第20図に示すごとく活 用されている。

すなわち、HTD の入力界磁は一定の抄紙速度の指令 を与える、定電圧電源とセクション電動機に直結された 速度計発電機の回転数に比例した誘起電圧との差によつ て励磁される。電動機に負荷変動のあつた場合は、電動 機速度の負荷変動率による速度変化分を補正するための アンペアターンをHTDが与えることになるが、HTDの

ただし B_s: 分巻磁極の空隙磁束密度 (gauß)

δ_s: 分巻磁極の空隙長 (cm)

a: 正饋還電力と出力との比率

しかるにカットオフ周波数附近では (9) 式の $\{1+(\tau_s\omega)^2\}$ の進相要素が相当効果をもつているのが普通であり、その場合カットオフ周波数は

$$\omega_0 = \frac{A_{p0}}{\mu^2 \cdot \tau_c} = \frac{K_1 \cdot v_a \cdot (A_c)}{B' \cdot \delta} = 4f \cdot \left(\frac{A_{Ta}}{A_{Tf}'}\right) (rad/s)$$
.....(20)

ただし B': 制御界磁,磁束密度と分巻界磁,磁束 密度(制御界磁に換算した)との和 (gauß)

Arf': B' に対応する制御界磁アンペアター

ン (A)

となる。

すなわちカットオフ周波数はいずれの場合も電機子周 波数と界磁アンペアターンの電機子アンペアターンに対 する比に比例するという同様な関係となる。なおこの関 係は横軸刷子をもつ型の増幅機についても同様で,この 場合は (A_{Tf}) として,横軸刷子を通る電流による起磁 力を考えればよい。

(16)および(20)式などからわかるように,カットオフ 周波数は従来の HTD の方が大であるが,すでに述べた ように零からカットオフ周波数に至るまでの周波数特性 は分極 HTD の方がはるかにすぐれているから,入力制 増幅率が非常に大きいため,その入力はきわめて僅かで 十分であり,このことは電動機速度の変化がきわめて小 さいことを意味する。

しかし実際運転では、この誤差がいかに僅かであつて も、完全に零でないと、しばしばドロー調整を行う必要 を生ずるおそれがあるので、日立製作所では差動歯車を 用いた無定位制御方式を併用し、静定誤差を完全に零と している。







- 第22図 可逆分塊圧延機の直接速度操作概 略結線図
- Fig. 22. Skelton Connection Diagram for Direct Speed Control of Reversing Blooming Mill Motor

(2) 分塊 圧 延機の 速度制御

分塊圧延機の能率向上策としての加減速度増大は最近 の顕著な傾向であり、数千キロワットにおよぶ大容量電 動機でも、その基準正速度から基準負速度までの逆転時 間を1秒程度に短縮する傾向にある。第21図はこの速応 制御方式の一例を示す簡略図である。すなわち制御励磁 機に速度指令をあらわすアンペアターンを与え、指令電 圧を発生すると HTD の制御界磁に電流が流れ、これに よつて発電機電圧を発生し、発電機電圧が制御励磁機の 指令電圧にほゞ等しくなると、その誤差分で発電機の全 第24図 負饋還制御を行つた場合の周波数特性

Fig. 24. Frequency Characteristics of Negative Feed Back Control System

出力を発生することになる。

つぎに HTD を用いた負饋還制御を行つた場合に速応 性がよくなる理由を前にのべた周波数の概念で考えてみ る。第22図に示されたような増幅機がなく、負饋還制御 を行わない場合に副励磁機の界磁にいろいろな周波数の 正弦波電圧を加えた場合を考えると,それに対する発電 機の出力電圧は, 横軸に対数目盛の周波数をとつて示す と第23図のようになる。一方第21図のように負饋還制 御を行つた場合には,この制御系全体の周波数特性は, 第24図のようになり、第23図に比べるとはるかによくな つている。第24図の周波数特性が水平である限界周波数 ω₀ は, 普通制御励磁機の時定数は十分に小さいので, こ の系の中の閉ループの部分を開いた場合の周波数特性の カットオフ周波数にほぼ等しくなる。したがつて速応性 をますためには, 閉ループを開いた場合のカットオフ周 波数をあげることであり,このため安定度の許す範囲で 閉ループの増幅率をまし,またそのおのおのの時定数を 短かくする必要がある。また第25図に実際のオッシロを 示す。

(3) 可逆冷間圧延機の張力制御

薄板の冷間圧延においては均等な厚みの板をうるため

日立評論 電動力応用特集号 別冊第8号







リール電動機用発電機電圧と,スト リップ速度とが比例している場合は おのおののリール電動機電流を一定 に維持することによって満足され る。この張力自動制御の一例を**第26** 図に示す。すなわち負荷電流は電動 機と発電機の補極および補償巻線の 部分の抵抗電圧降下として検出さ れ,HTD で増幅されて電動機の界 磁を制御し,反起電力を制御するこ とによって電流を一定に保持するの である。

張力の指令は HTD に与えられているが,いまこれを 単位函数的に変化した場合の,被制御量である電動機の 負荷電流の応答を第27図のオッシロに示す。

〔VI〕結 言

以上従来の HTD と,新型分極 HTD の特長性能など を述べ,あわせてその二,三の応用例を紹介したのであ るが,要するに増幅発電機としての必要条件は,高い増 幅率と短い時定数であり,高周波になつても増幅率の減 衰しないことである。

Tension Connection Diagram of for



Fig. 27. Test Result of Tension Control

には, 圧延機の前面および後面における板の張力を精密 に一定に保つ必要があり, この条件は巻取または巻戻し さらに位相おくれの少いことも系の安定度の観点から 重要な条件である。すなわちある周波数に対して,閉ル ープ内の位相おくれのため,負饋還されるはずのものが 正饋還となるようになれば不安定となるおそれがある。

しかしながら実際に増幅器を用いて一つの制御系を構成した場合,その制御系の動作は増幅機のみならず他のすべての構成要素の特性に支配されるものであるから, 増幅器とともに他の構成要素を含め系全体として綜合的に考慮することが必要である。

終りにあたつて種々御指導を賜わつた日立製作所日立 工場稲木部長,山本課長,泉課長,田附主任および日立 研究所小林主任に厚く御礼申上げるとともに試験,測定 に御尽力を頂いた木村氏,坂井氏に厚く感謝する。

参考文献

- (1) 田附: 電学誌 Vol. 72 No. 769
- (2) 田附,吉田,笠原: 日立評論 33 1036 (昭 26)
- 3) 稲木: 日立評論 19 611, 781 (昭 11)
- (4) Brown and Campbell: Principle of Servomechanism

- 136 -----